(A1)

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

G00002

(43) 国際公開日
2002 年7 月25 日 (25.07.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/058128 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/316, 21/31

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/00268

(22) 国際出願日: 2002 年1 月17 日 (17.01.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2001-12384 2001 年1 月19 日 (19.01.2001) JP
特願2001-30940 2001 年2 月7 日 (07.02.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 水谷 洋二 (MIZUTANI,Yoji) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 山口 正雄 (YAMAGUCHI,Masao) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO,Tetsuo et al.); 〒162-0065 東京都 新宿区 住吉町１－１２ 新宿曙橋ビル はづき国際特許事務所 Tokyo (JP).

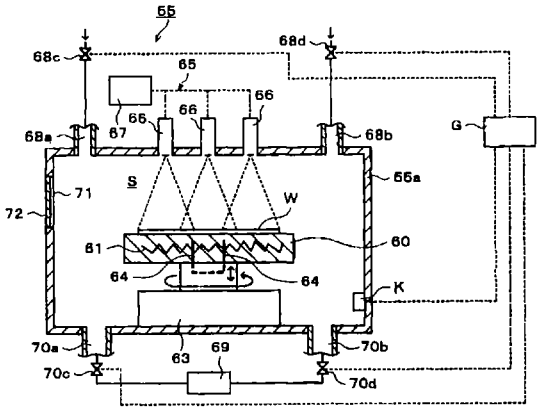
(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: METHOD AND APPARATURS FOR TREATING SUBSTRATE

(54) 発明の名称: 基板の処理方法及び基板の処理装置



(57) Abstract: A method of treating a substrate which comprises forming an interlayer insulating layer through application and irradiating the layer with an electron ray in a treatment chamber, thereby curing the interlayer insulating layer. The method allows an interlayer insulating layer to be cured in a markedly shorter time than that required for a conventional method.

(57) 要約:

162162

本発明は，基板上に層間絶縁膜を形成して，当該層間絶縁膜を従来よりも短時間で硬化させることを目的としている。

本発明は，基板を処理する方法であって，基板上に塗布形成された層間絶縁膜に対して，処理室内で電子線を照射することによって，当該層間絶縁膜を硬化させる。

WO 02/058128 A1